

Spezifikationen

Artikelnummer	RQ5E035ATTCL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 3.5A TSMT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6494 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TSMT3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 3.5A, 10V
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	SC-96
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	475pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.5A (Ta)

sein:

RQ5E035BNTCL
Rohm Semiconductor
MOSFET N-CH 30V 3.5A TSMT

ROHM
SEMICONDUCTOR

LAPIS
SEMICONDUCTOR

Kioxia

RQ5E035BNTCL MOSFETIGBTIC
ROHM
ROHM TSMT3



ROHM
SEMICONDUCTOR

LAPIS
SEMICONDUCTOR

Kionix



RQ5E030AJTCL
Rohm Semiconductor
NCH 30V 3A MIDDLE POWER
MOSFET

RQ5E035AT
ROHM
RQ5E035AT ROHM

RQ5E035BN
ROHM
RQ5E035BN ROHM

RQ5E035XN
ROHM
RQ5E035XN ROHM



 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.

RQ5E040AJ
 ROHM
 RQ5E040AJ ROHM

Mehr

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**
HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.
Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited